

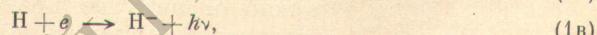
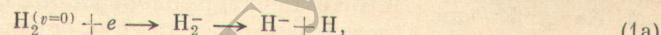
УДК 539.184+535.38

СВЕЧЕНИЕ АТОМНЫХ ЛИНИЙ В УСЛОВИЯХ ИОН-ИОННОЙ РЕКОМБИНАЦИИ И КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ИОНОВ H^-

B. B. Кучинский, B. Г. Мишаков, A. С. Тиболов и A. M. Шухтиц

Наблюдалось изменение характера свечения атомных линий щелочных металлов при добавлении водорода. Условия разряда таковы, что основным механизмом заселения возбужденных уровней щелочных металлов являлась ион-ионная рекомбинация с водородом. Оказалось, что ряд особенностей наблюдавшегося свечения и значение концентрации H^- , которую удалось оценить, не могут быть объяснены в рамках обычного механизма образования H^- — диссоциативного прилипания при учете молекул H_2 лишь в основном колебательном состоянии. Расчет показывает, что в условиях плазмы средней плотности ($n_e \approx 10^{14} \text{ см}^{-3}$) основная доля отрицательных ионов образуется с участием возбужденных колебательных состояний.

В настоящей работе рассматривается эффективный механизм образования отрицательных ионов водорода H^- в плазме средней и большой плотности при концентрации электронов выше 10^{13} см^{-3} . При низких давлениях обычно принимаются во внимание следующие реакции образования H^- :



где $\text{H}_2^{(v=0)}$ — молекула водорода в основном колебательном состоянии ($v=0$).

Как показано в работе [1], в импульсном разряде в смеси паров Na , H_2 и инертного газа при плотностях тока порядка нескольких сот ампер на cm^2 основным способом заселения Na^* является ион-ионная рекомбинация



На доводах, говорящих в пользу этого механизма, мы останавливаться не будем, отметим только, что в результате полной ионизации Na (остается менее 10^{-5} от исходной концентрации Na) обычный путь заселения возбужденных состояний — возбуждение электронным ударом дает меньший вклад, нежели реакция (2). Таким образом, наблюдая свечение линий Na в таком разряде, можно сделать некоторые замечания о кинетике образования H^- .

На рис. 1 представлена зависимость от времени интенсивности свечения головной линии диффузной серии натрия 818 нм ($3d-3p$). Измерения проводились также на резонансных линиях и на линиях побочных серий щелочных металлов $\text{Na}, \text{K}, \text{Rb}, \text{Cs}, \text{Li}$, причем характер свечения в импульсе оставался практически одинаковым. Импульсный разряд с модулятором на жестких лампах длительностью 8 мкс, ток $60-80 \text{ A}$, напряжение на анодах ламп $10-12 \text{ кВ}$ пропускался через разрядную трубку диаметром 12 мм, помещенную в печь. Нагреванием печи в трубке создавались пары Na ; концентрация атомов Na определялась мето-

дом крюков Рождественского. В трубку могли напускаться инертные газы и водород. Входная щель спектрографа помещалась в фокус линзы и диафрагмировалась, что обеспечивало наблюдение высвечивания из центральных частей разрядной трубы. Основные наблюдения проводились в режиме, характеризующемся следующими параметрами $n_e \approx (3 \pm 1) \times 10^{14} \text{ см}^{-3}$ (n_e определялась по уширению водорода H_β), $p_{Ne} = 4$ тора, $T_e = (70 \pm 8) \cdot 10^4 \text{ K}$ (T_e определялась методом двойного зонда). При добавлении в разряд водорода при парциальном давлении до 1 тора n_e и T_e оставались в пределах погрешности неизменным. Осциллограммы на рис. 1 сняты в этом режиме. Рис. 1, а — импульс тока, б — свечение в смеси $\text{Na} - \text{Ne}$, в — свечение в смеси $\text{Na} - \text{Ne} - \text{H}_2$. Как видно из рис. 1, с введением водорода характер свечения резко меняется. Из характерных изменений, связанных с введением водорода, отметим: появляется

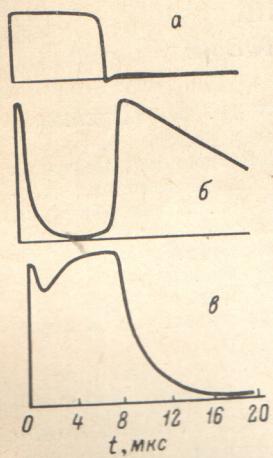


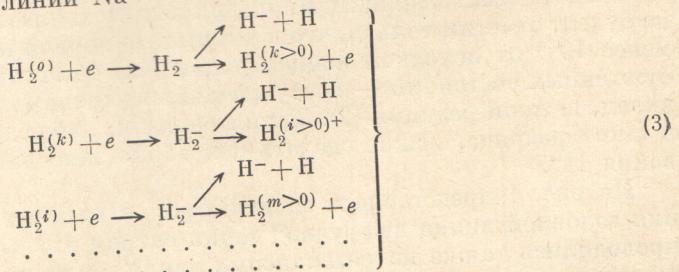
Рис. 1. Свечение линий Na I 818 нм.

a — импульс тока, *b* — свечение в смеси Na—Ne, $p_{\text{Ne}} = 4$ тора, *c* — свече-
ние в смеси Na—Ne—H₂,
 $p_{\text{H}_2} = 1$ тор.

$\tau_r = 1/\sigma_{i-i} n_{H^-}$. Отсюда получаем при $\sigma_{i-i} = 3 \cdot 10^{-16}$ см 2 и $n_{H^-} = 10^{17}$ см $^{-3}$, что на порядок превышает концентрацию H^- , рассчитанную в работе [1] для условий при учете реакции (1а).

Для объяснения полученных результатов мы предлагаем принять во внимание следующий способ образования H^- из молекулы H_2 , который в наших условиях может оказаться эффективным и объяснить наблюдаемые особенности свечения линий Na

Для объяснения полученных результатов мы предлагаем принять во внимание следующий способ образования H^- из молекулы H_2 , который в наших условиях может оказаться эффективным и объяснить наблюдаемые особенности свечения линий Na



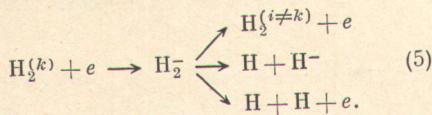
По существу предлагаемый механизм сводится к многократному возбуждению молекулы H_2 электронным ударом с последующим образованием H^- из колебательно-возбужденных состояний.

Эффективность этого механизма по сравнению с механизмом (1) связана с тем, что при реакции (1) из-за малого времени жизни автоионизационного

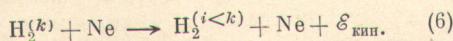
состояния H_2^- только небольшая часть ($\approx 10^{-(2+3)}$) образовавшихся в результате прилипания электрона молекул H_2^- живет достаточно долго, чтобы в результате разбега ядер система прошла критические точки ((R_+) и (R_-) рис. 2) и перешла в устойчивое состояние, дающее в дальнейшем ион H^- . Значительно большая часть $\sim 10^{-1}$ [3] образовавшихся в результате прилипания электрона молекул H_2^- за счет автоионизации перейдет в возбужденные колебательные состояния H_2 . Предложенный нами механизм учитывает вклад в образование отрицательных ионов именно этих колебательно-возбужденных молекул водорода. Очевидно, что необходимым условием эффективности предложенного механизма является условие

$$\tau_k \simeq A_{ke}^{-1},$$

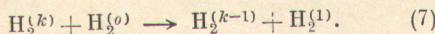
где τ_k — полное время жизни в k -том колебательном состоянии за счет всех процессов разрушения этого уровня, а A_{ke} — вероятность процесса



При оценке τ_k , кроме процесса (5), нужно учесть, очевидно, процесс превращения энергии колебательного движения в кинетическую энергию молекул



и для всех уровней с $k > 1$ процессы колебательно-колебательного размена



Как известно, сечение реакции (6) очень мало ($\approx 10^{-19} \text{ см}^2$), сечение реакции (7) значительно больше ($\approx 10^{-16} \text{ см}^2$). Таким образом, в наших условиях τ за счет процессов (5) и (7) порядка $3 \cdot 10^{-6} \text{ с}$, что при сечении $\sigma \simeq 10^{-16} \text{ см}^2$ для реакции (5) приводит к выполнению в наших условиях равенства (4). Разумеется, в электронных пушках, где обычно определяется сечение прилипания и в плазме малой электронной плотности предложенный механизм можно не учитывать, но в условиях мощного разряда, как нам кажется, учет его обязателен.

Предложенный механизм хорошо объясняет по крайней мере одну из наблюдавшихся особенностей свечения линий натрия: время нарастания свечения может быть связано с временем заселения колебательных уровней молекулы H_2 . Кроме того, может быть объяснено превышение концентрации H^- по сравнению с рассчитанной в [1].

Нами проведены некоторые теоретические оценки эффективности данного механизма. Полную картину образования H^- можно получить, решив систему уравнений (8) для заселенностей возбужденных колебательных уровней H_2

$$\frac{dn_i(t, T)}{dt} = -n_i(t, T) \tilde{Q}_i(T) + \sum_{k=1}^{16} n_k(k, T) \tilde{P}_{ki}(T), \quad (8)$$

где $\tilde{Q}_i(T)$ — есть суммарная вероятность процессов, приводящих к образованию иона H_2^- и к переходу молекулы $H_2^{(i)}$ в другое состояние по одному из трех каналов (5).

Возможность появления i -го состояния, описываемое вторым слагаемым (8) $\tilde{P}_{ki}(T)$, следует понимать как вероятность образования молекулы в i -состоянии за счет столкновения электрона с молекулой в k -м состоянии, т. е. вероятность первого канала (5).

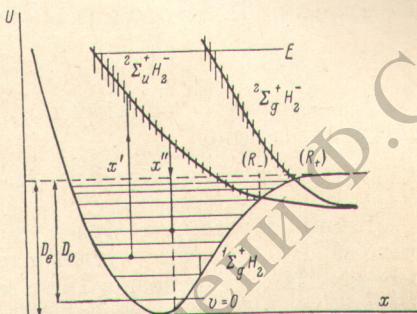


Рис. 2. Схема термов молекулы H_2 и молекулярного иона H_2^- .

Зная заселенность колебательных уровней, легко вычислить общий поток образующихся при развале H_2^- отрицательных ионов H^- . Для вычисления коэффициентов в системе уравнений (8), кроме параметров молекулы H_2 , в основном состоянии необходимо знать положение и полуширина термов $^2\Sigma_u^+$ и $^2\Sigma_g^+$ молекулы H_2^- , которые могут быть взяты из работ [4]. Однако решение системы (8) связано с большим объемом вычислительной работы, поэтому в этой статье мы ограничимся некоторыми оценками.

Прежде всего интересно оценить максимально возможную скорость образования H^- за счет предложенного механизма и сравнить ее со скоростью образования H^- за счет реакции (1а).

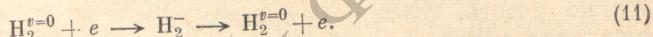
Нами вычислялась величина

$$\alpha \equiv \frac{I_{\text{прил.}}^0 - I_{00}}{I_{00}}, \quad (9)$$

где I_{00} — скорость образования H^- за счет реакции (1а). $I_{\text{прил.}}^0$ — скорость образования H_2^- за счет реакции



I_{00} — скорость образования H_2 в основном колебательном состоянии за счет реакции

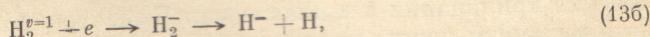
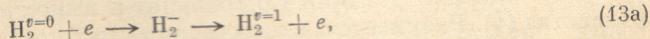


Таким образом, α будет действительно характеризовать увеличение выхода H^- за счет предложенного механизма, если предположить, что перевод H_2 из основного состояния в колебательное в конечном итоге приводит к образованию H^- за счет диссоциативного прилипания из возбужденного колебательного состояния. Для этого необходимо, чтобы n_v была достаточно большой для выполнения условия $\tau_k \gg \tau_v$.

Кроме того, интересно рассмотреть величину

$$\beta \equiv \frac{I_{01\infty}}{I_{00}}, \quad (12)$$

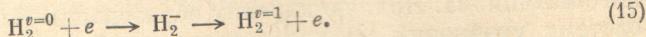
где $I_{01\infty}$ — скорость образования H^- за счет реакции



Причем для простоты вычислений будем считать, что реакция (13б) идет только из внешней точки поворота колебательного терма $v = 1$. Очевидно, что для $I_{01\infty}$ справедливо выражение

$$I_{01\infty} = I_{01}\eta_{1\infty}, \quad (14)$$

где I_{01} — скорость образования H_2 в первом колебательном состоянии за счет реакции.



$\eta_{i\infty}$ — вероятность того, что ион H_2^- , образовавшийся при прилипании электрона к H_2 в i -том колебательном состоянии, дает при диссоциации H^- ; η_{ik} — вероятность того, что ион H_2^- , образовавшийся при прилипании электрона к H_2 в i -том колебательном состоянии, дает при автоионизации H_2 в k -м колебательном состоянии. Очевидно, что представив I_{ik} через склонность прилипания электрона из i -того состояния и соответствующие вероятности η_{ik} , для α и β можно получить

$$\alpha = \frac{1 - \eta_{00}}{\eta_{0\infty}}, \quad (16)$$

$$\beta = \frac{\eta_{01}\eta_{1\infty}}{\eta_{0\infty}}. \quad (17)$$

Для η_{ik} мы предполагали правильными следующие выражения:

$$\eta_{i\infty} = \exp \left[- \int_{x_i}^R 2\Gamma(x) \frac{dx}{v(x)} \right], \quad (18a)$$

$$\eta_{i,i} = \exp \left[- \int_{x_i}^{1/2(x_{i+1}^i + x_i)} 2\Gamma(x) \frac{dx}{v(x)} \right], \quad (18b)$$

$$\eta_{i,i+1} = \exp \left[- \int_{x_i}^{1/2(x_{i+2}^i + x_{i+1}^i)} 2\Gamma(x) \frac{dx}{v(x)} \right], \quad (18c)$$

где $\Gamma(x)$ — полуширина терма H_2^- .

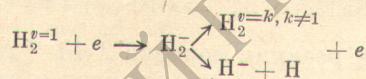
Предполагается следующее выражение для энергии терма H_2^- : $E = E_0(x) + i\Gamma$, $v(x) = \left\{ \frac{2}{\mu} [E_0(x_i) - E_0(x)] \right\}^{1/2}$. R — точка выхода терма H_2^- из континуума, x_i — внешняя точка поворота для i -того колебательного уровня, x_k^i — точка наибольшей скорости заполнения уровня k за счет реакции.

$H_2^- \rightarrow H_2^{v=k} + e$ при образовании H_2^- за счет прилипания электрона к H_2 в i -том колебательном состоянии. Согласно динамическому принципу Франка—Кондона, эта точка определяется из уравнения

$$E_0(x_i) - E_0(x_k^i) = \Theta_k - U_{H_2}(x_k^i),$$

где Θ_k — энергия k -того колебательного уровня, $U_{H_2}(x)$ — потенциальная энергия терма ${}^1\Sigma_g^- H_2$.

При таком определении η_{ik} автоматически выполняется нормировка на единицу суммы вероятностей развалов H_2^- по всем каналам. Кроме α и β , нами вычислялась также величина γ , равная вероятности ($\text{в } \text{с}^{-1}$) разрушения первого колебательного уровня за счет реакции



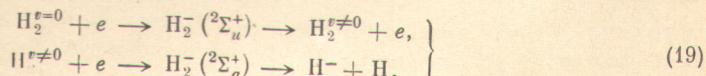
в условиях нашего эксперимента $\gamma = (1 - \eta_{11}) n_e \langle \sigma v_e \rangle_1$, где $\langle \sigma v_e \rangle_i$ — вероятность прилипания электрона к H_2 в i -том колебательном состоянии.

Из принципа детального равновесия следует, что $\langle \sigma v_e \rangle_1$ связана с величиной $\Gamma(x_1)$ соотношением

$$\langle \sigma v_e \rangle_1 = 2\Gamma(x_1) \frac{\omega_{H_2}}{\omega_{H_2^-}} \left(\frac{2\pi}{kT_e} \right)^{3/2} \exp \left\{ - \frac{E_0(x_1) - U_{H_2}(x_1)}{kT_e} \right\},$$

где ω_{H_2} , $\omega_{H_2^-}$ — статические веса H_2^- и H_2 соответственно. Величина γ^{-1} характеризует время установления потока H^- за счет реакций (13). Расчет α , β и γ производился нами первоначально с учетом терма ${}^2\Sigma_g^+$ молекул H_2^- . Выражение для $E_0(x)$ и $\Gamma(x)$ были взяты из работы [5]. Были получены следующие значения α , β и γ : $\alpha = 47$, $\beta = 0.1$, $\gamma^{-1} = 0.6 \text{ мкс}$. α , β и γ для терма ${}^2\Sigma_g^+$ вычислялись также при $E_0(x)$ и $\Gamma(x)$, рассчитанных в приближении потенциалов малого радиуса [6]. Получены следующие значения: $\alpha = 37$, $\beta = 6$, $\gamma^{-1} = 1.0 \text{ мкс}$.

Аналогичные вычисления для терма ${}^2\Sigma_u^+$ молекулярного иона H_2^- нами не проводились, в связи с тем что вопрос о вкладе этого терма в реакцию (1a) в настоящее время не вполне ясен. Однако следует учесть влияние этого терма в следующем механизме:



Эффективность этого процесса можно характеризовать величинами α^* и β^* , аналогичными α и β ,

$$\alpha^* = \frac{1 - \tau'_{00} \langle \sigma v_e \rangle'_0}{\tau_{0\infty} \langle \sigma v_e \rangle_0},$$

$$\beta^* = \frac{\langle \sigma v_e \rangle'_0}{\langle \sigma v_e \rangle_0},$$

где штрихом обозначены соответствующие вероятности для процессов, связанных с термом $2\Sigma_u^+$ молекулярного иона H_2^- . Получены следующие значения $\alpha^* = 70$, $\beta^* = 1.8$. Расчет величины γ^* не производился, так как предварительные оценки показали, что $\gamma^* \gg \gamma$.

Таким образом, эффективность предложенного механизма может быть охарактеризована величинами: $\alpha_{\text{полн.}} = \alpha + \alpha^* = 120$, $\beta_{\text{полн.}} = \beta + \beta^* = 2$, $(\gamma_{\text{полн.}})^{-1} = (\gamma)^{-1} = 0.6$ мкс.

Как видно из полученного значения $\alpha_{\text{полн.}}$, выигрыш за счет многоступенчатого возбуждения может быть весьма значительным. Рассчитанные значения β и β^* показывают, что вклад процесса (13) в образовании H^- незначителен, а роль реакции (19) при $v=1$ сравнима с прямым диссоциативным прилипанием.

Таким образом, предложенный механизм реализуется в основном через верхние возбужденные колебательные состояния молекулы H_2 .

Отметим, что полученные значения γ^{-1} несколько меньше наблюдавшихся в экспериментах времен нарастания свечения линий Na, но, очевидно, полное время установления концентрации H^- за счет процесса (3) в целом, включая многоступенчатое возбуждение, может несколько раз превышать величину γ^{-1} .

В заключение рассмотрим еще один вариант предлагаемого механизма образования H^- , при котором первая часть процесса возбуждения колебательного уровня H_2 происходит не за счет электронного удара, а за счет ударов второго рода с возбужденными атомами и молекулами. Например, возможна следующая реакция:



где $k \leqslant 7$. Сечение этой реакции порядка $2 \cdot 10^{-15} \text{ см}^2$ и некоторых условиях она может давать очень заметный вклад в заселение высоких колебательных уровней. Особенно выгодным обстоятельством является то, что в этой реакции высокие колебательные уровни заселяются не путем многоступенчатых переходов, а непосредственно. Кроме того, для высоких колебательных уровней мала вероятность разрушения их за счет процесса (7), так как из-за ангармоничности для молекулы H_2 при $v=6 \div 7$ реакция идет с дефектом $\sim 5 kT_a$ при $T_a = 500 \text{ К}$.

Литература

- [1] П. А. Погорелый, А. С. Тиболов. Опт. и спектр., 25, 542, 1968.
- [2] D. R. Bates, T. J. M. Boyd. Proc. Phys. Soc. A, 69, 910, 1956.
- [3] G. R. Schulz. Phys. Rev., 135A., 988, 1964.
- [4] I. N. Bardslay, A. Hergenberg, F. Mandel. Proc. Phys. Soc., 89, 305, 321, 1966.
- [5] Сб. «Атомные и молекулярные процессы». Ред. Бейтс, гл. 14. Изд. «Мир», 1964.

Поступило в Редакцию 21 января 1975 г.